

反應堆屏蔽設計手冊

塞歐寶爾·洛克韦耳 編

益 羣 譯

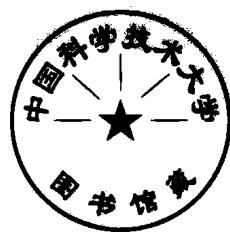


中国工业出版社

反應堆屏蔽設計手冊

塞歐寶爾·洛克韦耳 編

益 羣 譯



中国工业出版社

本书是根据俄文版“Зашита ядерных реакторов”(1958)一书翻译的。同时也参考了英文原版书“Reactor Shielding Design Manual”(第一版)。书名是根据英文书名翻译的。

материалы комиссии по атомной энергии США

**ЗАЩИТА
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ**

Перевод с английского

Под редакцией канд. физ.-мат. наук с.г. Цыпина
издательство иностранной литературы
Москва, 1958

反应堆屏蔽设计手册

益 羣 譯

*

中国科学院原子核科学委员会編委会編輯
中国工业出版社出版(北京修麟閣路丙10号)
(北京市书刊出版事业許可証出字第110号)
中国工业出版社第一印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本787×1092 1/16 · 印張25³/8 · 字數380,000
1962年8月北京第一版 · 1962年8月北京第一次印刷
印數 001—900 · 定价(10-5)3.05元

*

统一书号: K15165 · 1696 (核-17)

英文版序

在本手册內，闡明和列出已建成的軍艦用反應堆和希平港壓力水冷式反應堆(PWR)的屏蔽設計、建造和試驗所用的方法和數據。這些方法和其它反應堆上用的方法很不相同。

起初适用于軍艦用反應堆的這套工藝方法，實際上也完全适用于PWR反應堆。這一點，說明本手册對建造非軍艦用的其它反應堆也是有益的。不能設想，只有移動式的反應堆裝置才需要仔細地設計屏蔽層。不好的固定式反應堆的屏蔽結構，會使造價昂貴，修理不方便，使靠近孔道和部件接縫的地方的放射性水平升高，也可能由於核反應發熱之故，使圍繞活性區的部件受的應力過大。反應堆屏蔽層結構不好，會使載熱劑第一迴路中的設備活化，使熱交換器中的水分解，而導致第一屏蔽層材料的腐蝕加劇或輻照破壞。設計反應堆操縱系統的探測器，是根據屏蔽設計人計算的中子通量強度的數據進行的。設計探測器的錯誤，會使得反應堆功率升高而無法控制，或使這些儀器破壞。

在本手册內所提出的方法，有兩個特點：第一，這些方法是在現有的動力原子核反應堆上檢驗過的；第二，這些方法的基礎不是模擬，而是用理論方法處理問題，這可以使屏蔽設計不必花很高的代價，也不需要為了在反應堆上進行試驗而花費很多時間去製造實際屏蔽層的模型。

在本手册內集中了豐富的屏蔽設計實際工作經驗。在書本上有許多看起來是很吸引人的理論方法，但實際上這些方法幾乎毫無實際價值。屏蔽設計的大部分困難，主要是設備布置和結構設計，而不是只適用於理想的原子核反應堆的數學計算。在理想的設備上，從來沒有薄弱部分、縫隙、漏束的通縫或間隙。在這方面，極重要的是水不同於其它材料，水可以保證屏蔽層的均勻性。

為了準備這本手冊，塞歐寶爾·洛克韋耳Ⅲ做了很多工作。他曾領導了軍艦用反應堆和PWR反應堆的屏蔽設計工作。

美國原子能委員會反應堆管理局
軍艦反應堆處處長 H.G.里科維爾

英文版編者前言

本手册的目的是对工程师和科学工作者在屏蔽设计中有所帮助，因为其中有关于工程和方法的数据资料，这些方法是在完成军舰用反应堆和PWR压力水冷式反应堆的建造过程中形成的。全部内容是按照一定顺序编排的，以便设计人员在设计自己特有的结构的屏蔽层时，可以逐渐地掌握这些内容。并且也极其注意了数据资料的系统化和叙述方式最能通俗易懂。

首先向读者介绍一下手册的内容。在每章开头都有引言。本书这样编写方法，比利用一切直接名词和间接名词的索引来寻找所关心的某一问题的资料，更方便些。

为了把研究军舰用反应堆的各部门专家们最初编写的全部资料加以综合，并加以连贯地叙述，曾召开过许多大会和比较短时间的讨论会。因此，各章的原作者虽然未指明，但这本书是集体创作。关于技术数据的来源和提出某种方法的作者，在一切已知的情况下，在许多问题上都有相应的注解。本书希望在这些方面没有任何的遗漏。

鉴于原子核反应堆屏蔽的研究发展到现阶段，本手册不能认为是完善的，其中讲的都是已经知道的东西，但实践中尚未检验过的东西讲的较少。看起来，过一年多，本手册再版时，应该补充一些章节——热屏蔽层的设计；不溶解的分裂产物在反应堆设备内的分布；为了建造更精确的屏蔽层选择剂量测量点；关于屏蔽层几何条件的一些问题，如辐射的漏束和散射，屏蔽用大型铅块制造方法的降价，以及反应堆屏蔽层和载热剂屏蔽层是否相适应的评定方法的改善。

随着编写本手册的过程，由许多文章中越来越看得清楚，虽然在这里所提出的方法，对设计、建造、试验和使用动力原子核反应堆的各种型式屏蔽层都是适用的，然而在这些方法中，还是有过于繁琐的，不够经济的和根据不足的。如理论计算远未在一切必要的情况下经过实践检验。特别对第八章比其它各章更需要相似的实验来比较。编者和作者谨望从读者方面获得更有价值的技术数据和设计方法。这将是本手册被适当利用的证明，这也将是帮助我们再版时加以改进，俾使屏蔽层的建造工艺臻于完善。

我愿向海军上将里科维尔表示感谢，他第一个给了我编写这本手册的想法，并鼓励作者们和我细致地工作，根据需要，虽然对日常工作有所影响，但这些细致的工作是必需完成的。特别应该提出的，在编辑这本手册时，情报服务总局和橡树岭分局给予了巨大的帮助。

美国原子能委员会反应堆管理局
军舰反应堆处技术主任 塞欧·塞·洛克韦尔 III

目 录

英文版序.....	1
英文版編者前言.....	2

第一章 諸哲和屏蔽的基本理論

1. 屏蔽設計原則.....	1
2. 中子輻射的減弱.....	3
2.1 中子輻射減弱的基本過程 2.2 快中子的分出理論	
3. γ 輻射的減弱.....	6
3.1 源 3.2 γ 輻射減弱的基本過程 3.3 積累因子	
參考文獻.....	10

第二章 輻射的允許水平

1. 問題的提出.....	11
2. 輻射和放射性的基本單位.....	11
2.1 定義和基本概念 2.2 測量單位 2.3 某些符號和關係	
3. γ 輻射和中子通量與劑量率的換算曲線.....	15
4. 采用的基本輻射劑量.....	17
5. 屏蔽計算采用的輻射水平.....	20
5.1 接近設備的問題 5.2 反應堆運轉的平均功率	
6. 與局部漏束有關的問題.....	21
參考文獻.....	21

第三章 反應堆活性區的屏蔽

引言.....	22
1. 滿功率運轉的反應堆活性區——輻射源.....	22
1.1 製變產物——初級輻射源 1.2 活性區中的次級輻射源 1.3 活性區外的源 1.4 從活性區屏蔽觀點討論各種源的相對貢獻	
2. 反應堆停止運轉後活性區內的輻射.....	36
3. 輻射減弱的計算.....	38
3.1 快中子的減弱 3.2 热中子通量的分布 3.3 活性區的幾何條件對快中子減弱 的影響 3.4 誤差的來源	
4. 屏蔽層內的發熱.....	64
4.1 引言 4.2 由活性區放出的 γ 輻射引起的發熱 4.3 由俘獲中子和中子非彈性 散射產生的 γ 輻射所引起的發熱 4.4 中子彈性散射引起的發熱	
參考文獻.....	71

第四章 反應堆冷卻系統的屏蔽

1. 引言	72					
2. 輽熱劑比放射性強度的計算	73					
2.1 最典型的活化反應實例	2.2 各種載熱劑的比較	2.3 活化方程	2.4 有效中子通量的計算	2.5 平衡 γ 放射性	2.6 在改變載熱劑在活性區內和整個循環時間的情況下載熱劑放射性強度的近似求法	2.7 平衡的中子放射性強度
3. 反應堆冷卻系統的 γ 輻射屏蔽	92					
3.1 輽熱劑 γ 輻射屏蔽層厚度的一般計算	3.2 斜射在屏蔽層上的 γ 輻射的減弱					
3.3 圓柱狀源的實驗描述	3.4 保證劑量相等的屏蔽層厚度的等劑量計算方法					
4. 反應堆冷卻系統的中子屏蔽	118					
4.1 N^{17} 放出的中子減弱函數 [10]	4.2 N^{17} 放出的中子的分出截面和張弛長度					
4.3 用蒙太-卡洛方法計算 N^{17} 的中子在水中通過的結果						
5. 等劑量精確計算的點的選擇	128					
參考文獻	129					
書刊索引	129					

第五章 設備的布置和影響 屏蔽總體設計的其它因素

1. 引言	130	
2. 對屏蔽層的要求	131	
2.1 反應堆屏蔽層（第一屏蔽層）	2.2 輽熱劑屏蔽層（第二屏蔽層）	
3. 反應堆設備的布置	131	
3.1 反應堆的屏蔽層	3.2 輽熱劑的屏蔽層	3.3 輽熱劑屏蔽層以外的空間
4. 對設備布置的特殊要求	133	
5. 距離影響	134	
6. 最佳的屏蔽層尺寸	136	
7. 鮑影屏蔽	136	
8. 重量及其在船內的分布	137	
參考文獻	138	

第六章 屏蔽層的建造

1. 材料	139				
1.1 引言	1.2 鐵	1.3 鉛	1.4 水	1.5 聚乙烯(CH_2) _n	1.6 混凝土
1.7 鉛玻璃	1.8 含硼材料				
2. 屏蔽 γ 輻射用的各種材料效果的比較	157				
3. 制造和安裝	163				
3.1 引言	3.2 γ 輻射和中子輻射複合屏蔽層的詳細結構	3.3 鉛屏蔽層的安裝			
4. 工作試驗	179				
4.1 目的	4.2 輻射測量儀器	4.3 儀器定標	4.4 屏蔽實驗的計劃和進行		

4.5 屏蔽实验的經驗

参考文献	189
关于中子屏蔽材料的书刊索引	190

第七章 停堆后系统的放射性(接近设备的问题)

引言	191
1. 主要辐射源的概述	191
1.1 载热剂本身的活化放射性 1.2 结构材料的活化放射性 1.3 光中子的形成 1.4 反应堆活性区中的裂变产物 1.5 反应堆活性区中的缓发中子 1.6 载 热剂中的杂质和腐蚀产物的活化 1.7 由于释热元件的腐蚀或破裂在冷却系统 中有的裂变产物	
2. 水工艺的一些问题	194
2.1 给水 2.2 设备材料的腐蚀 2.3 净化系统	
3. 载热剂中杂质的活化	197
3.1 假设 3.2 列方程式 3.3 解 3.4 通过杂质净化装置的流速的确定 3.5 离子交换器和过滤器内的放射性浓度 3.6 中子通量与时间的关系	
4. 冷却系统中的裂变产物	210
4.1 水冷式反应堆系统中的气体裂变产物的分布 4.2 气体裂变产物的连续漏出 4.3 裂变产物的瞬时漏出 4.4 气体裂变产物连续漏出问题的其他解决方法	

第八章 屏蔽层不均匀性的影响

1. 引言	217
1.1 一般问题 1.2 公式汇编	
2. 中子	220
2.1 中子通过矩形缝 2.2 中子通过圆柱形孔道 2.3 辐射通过环形孔道 2.4 屏 蔽层中小空腔的影响 2.5 沿钢结构的漏束	
3. γ 辐射	242
3.1 源的几何条件 3.2 矩形缝 3.3 圆柱形孔道 3.4 环形孔道 3.5 计算的 实验证明 3.6 屏蔽层中空腔的影响 3.7 沿钢结构 γ 辐射的漏束	
4. 辐射在屏蔽层边缘的散射	269
4.1 引言 4.2 γ 辐射的散射 4.3 中子散射	
参考文献	293
书刊索引	294

第九章 辐射源的几何影响

引言	295
符号	295
1. 辐射通量方程	296
1.1 点源 1.2 线状源 1.3 盘状源 1.4 无限大平板状源 1.5 正截头圆锥状 源 1.6 圆柱状源 1.7 球状源 1.8 e^{-b} , $E_1(b)$ 和 $E_2(b)$ 函数曲线 1.9 $F(\theta, b)$ 函数曲线	

2.公式推导	336
2.1 点源 2.2 线状源 2.3 盘状源 2.4 无限大平板状源 2.5 正截头圆锥状源 2.6 圆柱状源 2.7 球状源 2.8 $E_n(b)$, $F_n(t, \alpha)$, $F(\theta, b)$ 和 $G(\mu, h, b)$ 函数	
3.各种几何形状源的辐射通量的近似公式	350
3.1 线状源 3.2 盘状源 3.3 正截头圆锥状源	
4.散射辐射的影响	353
4.1 在无限大介质中散射辐射的积累 4.2 源内散射辐射的积累 4.3 通过几层不同的物质时散射辐射的积累	
5.铁、水、铅和混凝土的积累因子	356
6.由一种几何条件变换为其他几何条件	363
6.1 由盘状源变换为点源 6.2 由平面源变换为球状源 6.3 由平面源变换为圆柱状源 6.4 由盘状源变换为无限大平面源	
参考文献	364

第十章 基本数据

铅，铁和水的积累因子曲线和微分能谱	366~368
能量吸收系数和质量吸收系数与能量的关系曲线	369~371
屏蔽设计用的辐射损坏综合表	383
放射性同位素积累和衰变的图解	389
专有名词翻译对照	395

第一章 緒言和屏蔽的基本理論

由于反应堆及其組成部分可以发出游离輻射，所以要求保护工作人員的安全。而且，进行屏蔽时，應該注意到使屏蔽层有合理的造价、重量和大小。本手册的目的是給工程师——屏蔽設計的專門人員以必要的数据和知識，这些数据和知識有助于設計人員完成上述任务。本章介绍了为学习后几章所必需的一般原理，并对反应堆所产生的輻射減弱的基本过程作一简单的討論。

1. 屏蔽設計原則

屏蔽設計工作可由几个主要阶段組成：

1. 必須确定什么样的屏蔽型式能最好地滿足提出的要求：

a) 整体屏蔽：把反应堆及其組成部分全部包围在一起的屏蔽型式。

b) 分部屏蔽：当对反应堆局部屏蔽时，把放射性載热剂系統和反应堆本体分別安置在两个屏蔽区里，以便在停堆时能对設備进行維修，也就是说，可以有限制地进入某些区域。

c) “阴影”屏蔽：在这种屏蔽条件下，靠近反应堆的某些区域为屏蔽层所防护，因而这些区域是在屏蔽层的“阴影”中。这些地方例如走廊、操纵台或者专门的操作地方。在某些情况下，屏蔽层可以从各方面把上面列举的每个地方圍繞起来。

在一般情况下，最好的屏蔽层是考慮到所有这些情况而建造的。

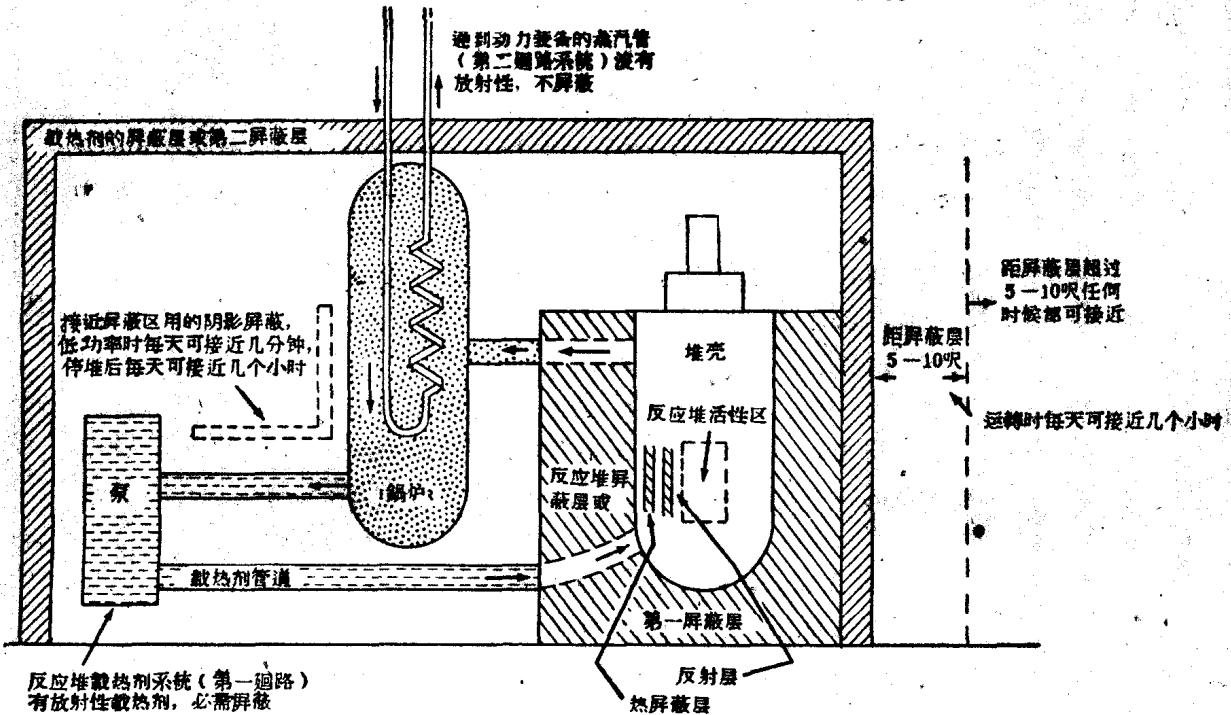


图 1 反应堆的分部屏蔽图

作为一个例子，在图1中举出了一个屏蔽层的示意图。图上标出了屏蔽层各组成部分的名称和一些名词。下面在第五章要研究一些因素，这些因素决定了对反应堆堆体屏蔽和对载热剂系统屏蔽的要求。

2. 必须确定当反应堆运转和停止工作的时候，在屏蔽层外面各个地方的辐射允许水平。这个问题将在第二章里讨论。必须指出，允许剂量的大小是穿过屏蔽层的各种辐射剂量的总和。

3. 应当知道进行屏蔽的放射源的分布、辐射能量和辐射强度。存在着很多的放射源但并非全是从反应堆中直接辐射出来的。所以：

- a) 在第三章里，研究的是由反应堆中直接产生的辐射；
- b) 在第四章里，研究的是由放射性载热剂所构成的辐射源；
- c) 在第七章里，研究的是和停堆时的辐射有关的一些最重要的问题。

4. 了解了所有这些问题以后，设计者可以着手计算所必需的屏蔽层厚度。设计者可以从下面解决这个问题的两种方法中选择一种：或者把载热剂系统看作圆柱体、圆盘、圆锥体、球体和其他最简单的几何形状的组合体来研究，而分别计算每个组成源的辐射对屏蔽层以外有关一点的贡献；或者把源当成很多点源的总和（把屏蔽层放在源和探测器之间），用计算机来计算对这些点源的屏蔽层厚度。必需的减弱程度可以用铁的等效厚度来表示。再把铁制的结构物、容器和其他元件除去，把剩余的厚度表示成所要用的屏蔽材料的厚度。只有在屏蔽设计中，通过经验的积累才可使这些计算做得最简单。在第三章和第四章里，将利用数据和最简单的例子阐明上述计算方法。

5. 在屏蔽层里面管道系统和热交换器系统的布置，以及在屏蔽层外部某些地点是否要接近的问题，在使屏蔽层具有最低造价和最轻重量方面起着重要的作用；这个问题将在第五章里研究。

6. 选择什么样的屏蔽材料，决定于材料的物理和屏蔽性能，决定于材料是否容易获得以及它的成本。这个问题将在第六章里讨论。

7. 屏蔽层的结构设计及其各个部分的制造，也在第六章里研究。在这一章里还要讲述铅和钢的连接方法，屏蔽用的水和其它液体的处理，以及混凝土的选择和利用的一些问题。

8. 屏蔽层安装前后的检查和试验问题，比最初所能指出的其它问题更为复杂。拟定屏蔽层的检查和试验计划，以及为此目的而选择设备报废的标准和试验的图表，典型试验的例子和所得的结果——所有这些问题都在第六章里叙述。

9. 停堆后的放射性辐射问题，在第七章里讨论。关于在管路系统各处放射性辐射的积累与衰减、各种放射性的大小，以及为了保持必需的放射性辐射水平所采用的净化系统的尺寸和载热剂化学成分的影响等问题，是用分析法研究的。并将所得结论与实际资料进行了比较。

10. 在屏蔽设计中，最值得注意的问题是：通过那些穿过屏蔽层的缝隙、热绝缘、设备结构零件的漏束。在第八章里列有一些数据和公式。

11. 辐射源的几何形状可能是很复杂的，而几何因子的计算又很枯燥；所以在第九章里给出了一些曲线，由这些曲线可以确定不同几何形状源的辐射剂量。

12. 在第十章里，给出了各种曲线、表格、图解法用的图、以及在屏蔽计算中可能用到

的其它參考資料。

13. 屏蔽設計人員的職責範圍包括对靠近反應堆的一些結構的輻射發熱的計算，這些結構是为了預防在其中产生溫度应力的危險。這些結構也影响整个屏蔽層的性能。這些問題，将在第三章里簡略地加以研究。

上述的屏蔽計算方法，是在动力用反應堆設備上研究出来的。但是这种方法也可以部分地用在熱室、運輸被照射过的釋熱元件的容器、源的容器、釋熱元件儲藏室、有放射源的包裝物等等的屏蔽計算中。

因为沒有可以从中找到現成結果的參考書，因此，每个屏蔽設計人員應該選擇进行計算或者为他所企求的其它目的而采用的标准。任何屏蔽層都耗費金錢；占一定的位置；有重量；和牵涉到接近屏蔽層、以及觀察、維修、和进行實驗的可能性等問題。屏蔽設計人員必須明确，在給定的屏蔽層造價、屏蔽層的複雜性或輻射水平的条件下，应尽量使所牵涉到的問題（屏蔽層的接近性、觀察、維修和进行實驗的可能性等問題）的影响化为最小。人人都可以屏蔽一个反應堆并使得由反應堆內出來的輻射水平低于任何选定的剂量；但是屏蔽技术却是在限定了重量、体积、和造价的条件下实现屏蔽的一种艺术。

反應堆屏蔽設計人員应当考慮到两种类型的輻射：中子和 γ 輻射。这些輻射通过某些个别的过程与介质发生相互作用，这些过程可以簡化进行研究。本章其余的部分将简单的讲述中子和 γ 輻射通过介质的問題。恰当的把一些基本實驗和与實驗有关的理論綜合起来，就可計算很复杂的反應堆屏蔽；而且比在設計屏蔽时采用1:1模型的模擬办法（这个办法已是相当快的）还要快。

为了証实这个觀点，曾經进行了三种类型的試驗：

A) 1950年初在橡樹嶺國立實驗室的（水槽）“Lid tank”裝置上进行了整体屏蔽的試驗：把鐵層、鉛層和水層裝置在裂變源和探測器之間。这些試驗起初用模擬的办法进行的，但由于在本章2.2节中将要讲到的阿尔拜特-威爾頓的快中子分出理論的发展，使得在設計船舶用反應堆和固定式反應堆屏蔽时，模擬試驗并把模型再換算成实物大小的方法几乎不再被采用。

B) 在1951—1952年期間，在勃魯克海文和橡樹嶺國立實驗室进行了研究中子穿透和洩漏的試驗，这些試驗容許得到近似的估計縫隙和反應堆屏蔽層薄弱地方的影響的一些簡單公式。

C) 在倍梯斯的諾尔斯动力實驗室和海軍研究實驗室做过的中子源 N^{17} 和 γ 輻射源 N^{16} 和 Co^{60} 的各种試驗，以及西屋原子动力局在材料試驗反應堆和在阿尔科（爱德华州）海軍反應堆實驗裝置上做过的一些試驗，使我們更清楚輻射穿过屏蔽層的情況。

2. 中子輻射的減弱

首先應該指出，在实际設計中，中子和 γ 輻射的屏蔽是密切相关的。特別是，由中子輻射減弱引起的 γ 輻射，是決定反應堆屏蔽結構的重要因素。在本章仅仅研究和輻射減弱有关的基本過程；屏蔽設計的实际問題将在手冊的其余部分叙述。

2.1 中子輻射減弱的基本過程(1)

在中子通过屏蔽層时，可能：

1) 和氰核碰撞；在此过程中，中子能量被減小到从初始值至零的範圍內，而运动方向

在 0° — 90° 范围内变化；

- 2) 和氧原子核和重原子核发生弹性碰撞（类似台球碰撞）；
- 3) 和氧原子核和重原子核发生非弹性碰撞（类似蜡球碰撞）；
- 4) 最后，由于氢或其他物质对中子俘获的结果，使中子损失掉。中子被俘获主要是发生在热能范围内。

我们来研究上述的每个过程，并且用最简单的方法进行说明。

中子和氢核的碰撞通常与中子的吸收相联系着（从屏蔽的观点来看）。定性来说，这是正确的，因为在屏蔽层里中子和氢发生碰撞时，中子能量的减少和中子路程的增长和氢的总截面^①随中子能量的下降而迅速增长的事实有关。中子被氢核阻止是个快收敛过程，在这过程中为使中子慢化成热能中子所必需的距离的大部分，是由第一次碰撞所决定的。中子和氢只有少数的初次碰撞，才导致中子发生不大的能量和飞行方向的改变。这些受到轻微散射的中子，象没有被散射的中子一样通过了介质；这就使得中子减弱和指数规律有些偏离。按照指数规律，所有中子在第一次碰撞后将全部离开射线束。开始时不考虑这个所谓“积累”效应，这样，由于第一次碰撞，中子在氢中的分布将服从于指数规律。

由于第一次碰撞以后，中子在氢中的慢化是一个快收敛过程，因而可合理地假定：在第一次碰撞以后，中子所经过的路程是可以被忽略的。根据这点，开始我们采用：在热能范围内，中子吸收的空间分布正比于中子同氢核发生第一次碰撞的空间分布。

同样地，中子也能和氧或者重元素的原子核发生碰撞。同这些核碰撞后，中子可沿任何方向飞出，而它的能谱将依赖于初始能量和散射角。能量小于1兆电子伏的中子，在大多数情况下，发生弹性散射，当中子能量大于1兆电子伏时，非弹性散射的机率将随能量的增加而增大。

可以预料：在铅或铁中，非弹性散射的结果，能量大于2—3兆电子伏的中子将被慢化到1兆电子伏左右。与此相应的非弹性散射截面近似等于重元素总截面的一半。由于在低能范围内，氢对中子作用截面的迅速增长，这些失掉了自己能量的中子，将很快的为氢所慢化。这个推论表明，这样的非弹性散射相当于吸收。在这种情况下，同样地忽略了在非弹性散射以后到在热能范围内被俘获以前的中子的空间分布。

在低能情况下，弹性散射通常具有各向同性的分布。这些碰撞的结果等效于改变了中子运动方向，因此中子实际上并没有脱离屏蔽层。对于现有组成和厚度的反应堆装置的屏蔽，很容易证明：中子各向同性的弹性散射同样等效于吸收。

对于更高能量的中子（5—15兆电子伏），在屏蔽层中，重元素截面的大约一半相应于中子的小角度弹性散射。中子飞行方向的偏离与“不透明核”的“阴影”有关。对于低能中子（1—2兆电子伏），阴影散射的截面，可以最简单的作为各向同性来处理，因之可以当成吸收截面来研究。对高能中子，全部阴影散射发生在小的角度范围内，因之，可能在很大程度上对于中子的分出是无效的。为简单起见，可以假定：中子被重元素核的分出可以用与能量无关的截面来描述。对于在氧核上的散射作类似的假定，并且，用这两个常数（对于氧和重元素的中子分出截面）作为参考，这样所得到的结果，与在整体

① 截面被定义为粒子和元素的作用机率。在快中子散射时，截面近似等于原子核的理论面积（ $\sim 10^{-25} A^{2/3}$ 厘米²，这里A是原子量），在某些情况下（例如在热中子被俘获时）截面可大10倍。

屏蔽层上所测得的结果符合得最好。

2.2 快中子的分出理論

为了应用大量的、涉及整体屏蔽的資料并使其系統化，发展了快中子分出理論。提出的简单的計算方法，在相应的条件下使用时给出了极可靠的结果。得到这种方法是由于仔細地研究了中子和屏蔽层的相互作用，同时研究了那些在很大程度上决定中子穿透深度的过程。这个方法给出了表征中子在屏蔽层中穿透深度的平均数值，这个屏蔽层是由水和其他元素构成的，假設这些元素占屏蔽层体积的0—50%。象其他任何唯象理論一样，这个方法只能用于一定的条件下，对于有限范围内的問題能给出答案。

完全不顾这些限制，根据整体屏蔽层进行实验所得到的一些数据，理論上可以計算反应堆活性区的屏蔽层。这个理論把整体屏蔽的简单实验，和在实际計算屏蔽层时必然遇到的更复杂的問題结合起来（这些問題包括連續的結構改变）。

中子通量在屏蔽层內的分布可近似用指数函数来描述，也就是說，在每一吋屏蔽层上中子通量減少一定的百分数（在对数座标内是一直線），并遵守下列方程式：

$$\text{中子通量} = \text{常数} \times e^{-\Sigma x},$$

或者对于点源：

$$\text{中子通量} = \frac{\text{常数}}{4\pi r^2} \times e^{-\Sigma x};$$

式中 x —— 屏蔽层厚度；

Σ —— 常数；

r —— 从源到 x 点的距离。

这样，如果这个近似式由一个參量来确定，那么常数 Σ 将描写中子为給定物质所分出的量。常数 Σ_R ，称为分出截面，它的量綱是厘米² / 厘米³ 或厘米⁻¹。有时对于一个原子，

表 1 裂变中子的有效分出截面[6]

元 素 ^①	截 面(靶/原子) ^②	材 料	截 面(靶/分子) ^②
Li	1.01		
Be	1.07	CH ₂	2.8
(B)	0.97	C ₂ F ₈ Cl	6.6
C	0.81	B ₄ C	4.3
(O)	0.99		
(F)	1.29	D ₂ O	2.8
Al	1.31	C ₇ F ₁₈	26.3
(Cl)	1.2		
Fe	1.98	C ₈₀ H ₆₂	80.0
Ni	1.89		
Cu	2.04		
W	2.5		
Pb	3.5		
Bi	3.49		

① 注有圓括号的元素的有效分出截面是分析了含有这些元素的混合物而得到的。

② 引入的分出截面是对于裂变譜中子而言。借助于能量为 1 兆电子伏的中子源 (N^{17}) 而得到的分出截面的实验数据将在第四章给出。

写成 σ_R , 单位是靶(1靶= 10^{-24} 厘米 2), 这个时候在1厘米 2 内的原子数应作为独立的因素。为了确定分出截面的概念是否正确, 即使正确而又应该采用怎样的数值, 上面所研究的过程必须认为是单一的吸收过程。从对整体屏蔽实验结果得到的数据的分析和解释也可以看出, 用一个截面是否可以确定所有这些过程。这个方法的优点和限制, 将在第三章更全面地加以研究。必须指出, 选择一个截面对于屏蔽计算是方便的(氢除外, 这将在第三章中单独研究)。

近几年来, 在橡树岭国立实验室, 测量了许多材料的有效分出截面, 大部分数据列在表1中。列出的数值是分析了上面关于减弱的研究结果而得到的。把这些数据作成曲线, 它的形状和能量为8兆电子伏的中子总截面与原子量的关系曲线几乎是完全一样的(和LA-1655报告的数据相比较), 而且这些数据在总截面数据的40%左右。用等式 $\Sigma_R/\rho = 0.085A^{-1/3}$ 表示的近似值(这里 ρ ——密度; A ——原子量), 对原子量大于10的元素(6)是完全令人满意的。

3. γ 辐射的减弱

3.1 源

关于 γ 辐射和物质相互作用过程的基本知识, 可从任何一本较好的原子核物理教科书①中找到。在反应堆活性区中产生的 γ 辐射源, 将在第三章中作一般描述; 在反应堆载热剂中的源, 将在第四章中予以描述。放射性衰变图的资料是取自NBS No 499报告或赫兰德、皮尔曼和斯包尔格的同位素表②。放射性原子核的衰变特性和所含有的元素的数量决定了所研究的各个同位素的总辐射强度。

3.2 γ 辐射减弱的基本过程

γ 辐射强度的减弱, 取决于两个因素:

- 1) 源和辐射接受体之间的距离;
- 2) γ 辐射与介于源和接受体之间的介质的相互作用。

当所研究的源不大(点源), 并且在空间布置上没有任何限制时, 距离引起的减弱将是重要的。假若远离源实际上是不可能的, 那么, 由于与介质的相互作用而造成的减弱, 将成为基本的。(注意到由屏蔽观点来看, γ 辐射的减弱过程和在本章第2节中讲过的简化了的中子减弱过程的相似处)。象在第九章中将指出的那样, 对于不同几何形状源的所有公式, 可以从下面点源 γ 辐射的减弱方程中推导出来:

$$D = \frac{S_0 B e^{-\mu x}}{K 4\pi r^2}.$$

式中 D —— 剂量率(以剂量率单位表示);

S_0 —— 点源每秒发出的 γ 光子数(光子/秒);

B —— 积累因子(无量纲——参考下面);

x —— γ 辐射穿过的屏蔽层厚度(以长度单位表示);

μ —— 线性吸收系数(若用厘米表示 x , 则 μ 为厘米 $^{-1}$);

① 例如: Halliday D. Elementary Nuclear physics.

② Hollander, Pearlman, Seaborg, Table of Isotopes, Reactor Handbook Report AECD-3645.

K —— γ 光子通量換算为剂量率的系数(参考第二章);

r ——从源到接受体的距离(以长度单位表示)。

μ 和 B 的值需要进一步的討論。綫性吸收系数 μ 是能量和材料的函数。 μ 的数值在第十章给出。在G.R.怀特的評論性報告(NBS№1003)中,給出了很多关于 γ 輻射的最主要的数据,其精确度高于2%。

为了从理論上研究 γ 輻射吸收,我們建議去參閱有关这个問題的文献。特别是在U.法諾①的文章中,对这个問題分析得全面而又清楚。这里仅仅指出, γ 輻射的減弱是由三种不同过程造成的,这三种过程是:光电吸收、产生电子对和康普頓散射。前面的两个过程伴随着 γ 輻射的消失。在康普頓散射的情况下, γ 光子和电子的相互作用改变了光子的运动方向,同时仅仅损失掉初始能量的一部分。由于在定义数值 μ 时沒有考慮到那部分 γ 光子实际上也穿过了屏蔽层,因此, γ 輻射的真正減弱并不象按指数規律所得到的那样大。所以在上面引入的公式中和在研究第九章中所闡述的問題時,我們引进了积累因子 B 。

3.3 积累因子

实际的 γ 輻射通量和应用綫性吸收系数按指数減弱規律計算而得到的通量的比值被定义为积累因子。这个定义給出了粒子数的积累因子。但是,在剂量率表示式中,这个定义可作为剂量积累因子;在能量穿过的表示式中,这个定义可作为能量积累因子;在能量吸收表示式中,这个定义可作为能量吸收积累因子。

描述 γ 輻射貫穿的迁移方程的精确数字解的方法,是斯宾塞和法諾[2]制定的,这个方法包括解空間矩的联立积分方程組和矩的变换,以便得到空間分布。为了确定能量从0.5—10兆电子伏的 γ 輻射的貫穿特性,在标准局的計算机(SEAC)上进行了一系列計算。这些計算是对八种不同原子序数的屏蔽介质进行的。所得到的数据和各向同性点源的积累因子計算曲綫一起在報告[7]中举出;这些資料的一部分摘录在第十章里。

这些曲綫仅仅是相应于圍繞着源的均匀介质的。若屏蔽层由几种材料組成,則总的衰減长度的值(对应于 $\mu x = 1$ 的距离,也就是說, γ 輻射減弱到 e 倍或2.7倍)等于屏蔽层所有組分的衰減长度的总和。目前还没有一种最好的方法能在任何情况下选择积累因子的值。下面列出一些不同类型的屏蔽层:

a)一种材料的屏蔽层。在NYON№3075的報告中和在第十章中,列出了对于各向同性的点源,在无穷大介质內 γ 輻射的积累因子的最可靠的数据(这些数据是NBS—NDA②得到的)。

第一種情況:根据国家标准局——核子发展学会的計算(这些計算在WAPD.TN№217的報告中举出),积累因子可以表成两个简单的指数項和的形式:

$$B_{cuT}(\mu_0 x, E_0) = A_1(E_0) \exp[-\alpha_1(E_0)\mu_0 x] + A_2(E_0) \exp[-\alpha_2(E_0)\mu_0 x]$$

式中: $B(\mu_0 x, E_0)$ ——积累因子(在点 $\mu_0 x$ 处,散射的和未經散射的 γ 輻射的通量与未經散射的 γ 輻射通量的比值);脚标C表示減弱的介质,脚标u——源的几何形状,脚标T——积累因子的类型(类型决定于粒子数目通量、能量通量或者剂量率); μ_0 ——能量为 E_0 的 γ 輻射的綫性吸收系数;由 B_{cuT} 的定义可知 $A_1 + A_2 = 1$ 。

① Fafo U. Nucleonics № 8, 9 (1953).

② NBS——国家标准局(美国)。

NDA——核子发展学会(美国)。

在第九章中给出了四种最普通的材料(铁、铅、水和混凝土)的参数 α_1 、 α_2 和 A_1 与能量的关系曲线(对于各向同性点源),剂量积累因子曲线,能量积累因子曲线和能量吸收积累因子的曲线。

第二种情况: 在有限范围内,也就是在 μx 变化不大的范围内,积累因子可表成 $B = 1 + \beta \mu x$ 的形式,或表成在第三种情况下的形式。

第三种情况: $B = \beta (\mu x)^{\alpha}$ 这里 β 和 α 是与材料及能量有关的常数。

在确定源的几何形状的影响时,所引入的公式对于解析的表示和进行积分计算是很方便的(参考第九章)。

如果假定:对于板状屏蔽层的积累和对于无穷大介质的积累是一样的,那么就可以用第一种情况来描述通过板状屏蔽层的 γ 辐射的影响。在这种情况下,运用和斜入射的 γ 辐射的穿透有关的附加屏蔽层是行之有效的方法。然而,由威斯科夫的实验资料可以看出,屏蔽斜射的 γ 辐射的附加屏蔽层只能用于角度小于 30° 的情况下。由皮波斯[4]的计算证实了这一点,他的计算以及斜射的 γ 辐射的积累因子的数值被引在文献[4]中。很遗憾,皮波斯的计算和国家标准局——核子发展学会对 γ 辐射的直接穿透的数据是不一致的。所以在计算斜着穿过的 γ 辐射时,必须把皮波斯的数据统一为国家标准局——核子发展学会对直接穿透的数据(参考第四章3.2节)。

b)几层不同材料构成的屏蔽层:为了计算几种不同材料层组成的屏蔽层的积累因子,曾经提出过几种方法。下面我们将研究其中的一部分。

- 1)假若在轻材料后面是重材料,那么只应用对重材料的积累因子。
- 2)假若在重材料后面放置轻材料,则应用两种材料积累因子的乘积。在多于两层时,也建议采用这个方法,但这会使得屏蔽层的厚度过于安全。
- 3)积累因子可以按照每一种屏蔽材料的衰减长度来进行平均。
- 4)利用第六章(图74-78)举出的曲线,可以有条件地把屏蔽层转换为一种材料组成的等效屏蔽层。然后运用这种材料的积累因子。

c)均匀混合物。若屏蔽层是均匀混合物,例如混凝土,则积累因子可用戈尔斯坦的方法来计算。按照这个方法,奥本逊做过对于混凝土的计算。方法如下所述:为了得到混合物的积累因子,必须确定有效原子序数 Z 。对于确定的 E_0 值,可把各种因素的积累因子用图表表示为原子序数 Z 的函数,同时取平均自由程作为参数。

现在问题就归结为找寻这样的元素,它对于 γ 辐射的散射和吸收的特性与混合物是一致的。材料对于 γ 辐射的散射和吸收的特性取决于与每个原子核相结合的总电子数的份额。这个份额可按下面公式来计算:

$$\beta_i = \frac{a_i Z_i / A_i}{\sum_{i=1}^n a_i Z_i / A_i}.$$

式中 a_i —混合物中 i 种元素的重量百分比;

Z —原子序数;

A —原子量或分子量。

假如对一个电子来说吸收系数为 μ_i ,则材料的总吸收系数由下式确定:

$$\mu(E) = \sum \beta_i \mu_i(E).$$